

УДК 537.533.3

Поле тороидального конденсатора со слабодеформированными электродами. Явор М.И.//
Научное приборостроение. Электронно-ионная оптика. Л.:Наука, 1989, с.66-71.

Получены приближенные аналитические выражения для возмущения потенциала поля тороидального конденсатора, обусловленного деформацией его пластин. Результаты могут быть использованы для определения допусков на изготовление и сборку тороидального энергоанализатора. Приведено также более точное, чем в работах других авторов, выражение для коэффициента тороидальности поля недеформированного конденсатора. Лит. - 4 назв., ил. - 1.

ПОЛЕ ТОРОИДАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА СО СЛАБОДЕФОРМИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

Тороидальный дефлектор [1] в настоящее время является распространенным типом энергоанализатора, применяемым в двухкаскадных статических масс-спектрометрах. Сложность формы его электродов делает актуальной задачу об определении допусков на их изготовление и сборку, поскольку эти допуски влияют на выбор технологии изготовления, и, следовательно, на стоимость изделия. Задача расчета допусков требует в качестве первого, и, вероятно, наиболее сложного этапа умения вычислять возмущение потенциала электростатического поля тороидального конденсатора, вызванное слабой деформацией его пластин. Решению такой задачи и посвящена эта статья.

Идеальный (недеформированный) тороидальный конденсатор образован двумя осесимметричными поверхностями – тороидами, образующие которых (рисунок) – окружности радиусов R_1 и R_2 . Центры окружностей могут быть смещены относительно друг друга в радиальном направлении. Пусть r_1 и r_2 – координаты точек пересечения этих окружностей с осью r в цилиндрической системе координат $(r, \varphi; z)$, $B = (r_2 - r_1)/2$ – полузазор между электродами при $z = 0$, $r_0 = (r_1 + r_2)/2$ – радиус средней траектории частиц в конденсаторе. Назовем образующей поверхностью конденсатора тороидальную поверхность с образующей окружностью радиуса $R_0 = (R_1 + R_2)/2$, проходящую через точку $r = r_0$, $z = 0$,

с центром на оси r . Зазор между электродами обычно является достаточно узким, т.е. $\epsilon = \delta/r_0 \ll 1$. Вследствие этого кривизны образующих электродов мало отличаются друг от друга.

Метод расчета поля в тороидальном конденсаторе с заданной геометрией пластин [2-4] состоит в следующем. Выражение для поля строится в виде ряда по степеням $(r - r_0)^{\ell} z^k$ отклонения координат r, z от средней траектории. Коэффициенты ряда $a_{\ell, k}$ удовлетворяют рекуррентным соотношениям, вытекающим из уравнения Лапласа для потенциала поля. Для получения недостающих соотношений исходное разложение подставляется в граничные условия на поверхности электродов. Коэффициенты $a_{\ell, k}$ имеют вид асимптотических рядов по малому параметру ϵ .

Следует отметить, что работы [2, 3] имеют серьезные недостатки. В работе [2] аксиальная кривизна пластин предполагается малой ($R_1, R_2 \gg r_0$), т.е. конденсатор мало отличается от цилиндрического. Результаты работы [3] справедливы лишь при совпадении кривизн электродов ($R_1 = R_2$). Работа [4] свободна от указанных недостатков, однако в ней получены только старшие члены разложения коэффициентов $a_{\ell, k}$ по степеням ϵ . Если ограничиться лишь этими членами, то точность определения коэффициентов $a_{\ell, k}$ с малыми номерами ℓ, k явно недостаточна. В частности, входящий в коэффициент тороидальности c [3] радиус аксиальной кривизны R_c эквипотенциали, проходящей через точку $r = r_0$,

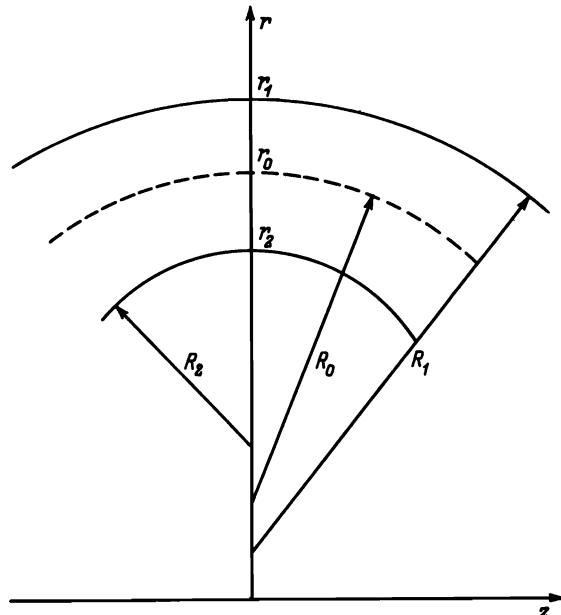
$z = 0$, определяется в приближении двухмерного поля ($R_c = R_0$). Результаты работ [2-4] получены, разумеется, в предположении об осесимметричности поля, от которого нам приходится отказаться.

В настоящей работе получено выражение для поля тороидального конденсатора со слабодеформированными электродами. Поле имеет вид ряда по степеням отклонения координат r, z от средней траектории и угла φ от некоторого фиксированного значения φ_0 (без снижения общности будем в дальнейшем считать $\varphi_0 = 0$). Кроме того, для недеформированного конденсатора получено выражение для коэффициента тороидальности c в квадратичном по ϵ приближении, т.е. с большей точностью, чем позволяет работа [4].

Запишем уравнения пластин конденсатора в виде

$$x = G(z) + \delta g_t(z, \varphi), \quad t = 1, 2. \quad (4)$$

Здесь $x = r - r_0$, $G(z) = -z^2/2R_0 - z^4/8R_0 - \dots$ – функция, задающая образующую поверхность конденсатора (уравнение образующей поверхности $x = G(z)$);



Образующие электродов недеформированного тороидального конденсатора

$g_t(z, \varphi) = \hat{g}_t(z) + \delta g_t(z, \varphi)$, \hat{g}_t – функции, описывающие поверхности недеформированного конденсатора (при отсутствии деформаций $\delta g_t = 0$), $\hat{g}_1(0) = 1$, $\hat{g}_2(0) = -1$, $\hat{g}_t(-z) = \hat{g}_t(z)$. Более конкретно вид функций \hat{g}_t зависит от геометрии электродов: если, например, образующие имеют одинаковые аксиальные радиусы кривизны $R_1 = R_2 = R_0$, то $\hat{g}_1(z) = 1$, $\hat{g}_2(z) = -1$. Если же совпадают центры аксиальной кривизны электродов, т.е. $R_1 = R_0 + b$, $R_2 = R_0 - b$, то

$$\hat{g}_t(z) = \pm 1 + \left\{ \pm \frac{1}{2R_0^2} - \frac{b}{2R_0^3} \pm \dots \right\} z^2 + \dots . \quad (2)$$

Функции δg_t характеризуют малые деформации пластин; предполагается, что $|\delta g_t| \ll |\hat{g}_t|$.

Потенциал поля конденсатора $U(x, z, \varphi)$ является решением задачи

$$\begin{aligned} \Delta U(x, z, \varphi) &= 0, \\ U(G(z) + \delta g_t(z, \varphi), z, \varphi) &= V, \\ U(G(z) + \delta g_2(z, \varphi), z, \varphi) &= -V. \end{aligned}$$

Для удобства использования результатов работы при анализе траекторий ионов в дефлекторе перейдем к безразмерным координатам $\eta = x/r_o$, $\varsigma = z/r_o$. Тогда (1) запишется в виде

где $F(\varsigma) = G(r_o \varsigma)/r_o$, $f_t(\varsigma, \varphi) = \hat{f}_t(\varsigma) + \delta f_t(\varsigma, \varphi)$, $\hat{f}_t(\varsigma) = \hat{g}_t(r_o \varsigma)$, $\delta f_t(\varsigma, \varphi) = \delta g_t(r_o \varsigma, \varphi)$. Соответственно $F(\varsigma) = -C_o \varsigma^2/2 - C_o^3 \varsigma^4/8$, разложение (2) принимает вид

$$\hat{f}_t(\varsigma) = \pm 1 + \left\{ \pm \frac{C_o^2}{2} - \epsilon \frac{C_o^3}{2} \pm \dots \right\} \varsigma^2 + \dots ,$$

где $C_o = r_o / R_o$.

В безразмерных координатах потенциал $U(\eta, \varsigma, \varphi)$ удовлетворяет уравнению Лапласа

$$\Delta U(\eta, \varsigma, \varphi) = 0 \quad (3)$$

и граничным условиям

$$U(F(\varsigma) + \epsilon f_t(\varsigma, \varphi), \varsigma, \varphi) = \pm \epsilon E, \quad (4)$$

где $E = r_o V/b$, верхний знак здесь и далее соответствует $t = 1$, нижний $-t = 2$.

В дальнейшем нам понадобятся разложения степеней функций $F^i(\varsigma)$ и $f_t^{(i)}(\varsigma, \varphi)$ в окрестности $\varsigma = \varphi = 0$. Запишем их в виде

$$\begin{aligned} F^i(\varsigma) &= \sum_{m=i}^{\infty} F_m^{(i)} \varsigma^{2m}, \\ f_t^{(i)}(\varsigma, \varphi) &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\ell} f_{t,p,\ell}^{(i)} \varphi^{e-p} \varsigma^p. \end{aligned} \quad (5)$$

При $i = 0$ предполагается $F_m^{(0)} = f_{t,p,m}^{(0)} = \delta_{mp}$, где δ_{ik} – символ Кронеккера. Для недеформированного конденсатора $f_{t,p,\ell}^{(i)} = 0$ при $p < \ell$, $f_{t,e,e}^{(i)} = \hat{f}_{t,e}^{(i)}$, $\hat{f}_{t,e}^{(i)} = 0$ при нечетных ℓ .

Будем искать решение задачи (3), (4) в виде

$$U(\eta, \varsigma, \varphi) = E \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} a_i(\varsigma, \varphi) \eta^i, \quad (6)$$

где

$$a_i(\varsigma, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_i^{(n)}(\varsigma, \varphi) \varepsilon^n, \quad (7)$$

и, в свою очередь,

$$a_i^{(n)}(\varsigma, \varphi) = \sum_{j, k=0}^{\infty} \frac{1}{j! k!} a_{i, j, k}^{(n)} \varphi^j \varsigma^k. \quad (8)$$

Подставляя (6)–(8) в уравнение (3), получим рекуррентные соотношения

$$\begin{aligned} & a_{i+2, j, k}^{(n)} + (2i+1) a_{i+1, j, k}^{(n)} + i^2 a_{i, j, k}^{(n)} + a_{i, j, k+2}^{(n)} + \\ & + 2i a_{i-1, j, k+2}^{(n)} + i(i-1) a_{i-2, j, k+2}^{(n)} + a_{i, j+2, k}^{(n)} = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Из (9) можно определить все коэффициенты $a_{i, j, k}^{(n)}$ при $i \geq 2$, если известны коэффициенты $a_{0, j, k}^{(n)}$ и $a_{1, j, k}^{(n)}$. Для определения последних подставим (6) в граничные условия (4). Имеем

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} a_i(\varsigma, \varphi) \{ F(\varsigma) + \varepsilon f_t(\varsigma, \varphi) \}^i = \pm \varepsilon. \quad (10)$$

Используя (7) и приравнивая в (10) слагаемые с одинаковыми степенями ε , получим

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{n \geq 0} \frac{a_i^{(n)}(\varsigma, \varphi)}{(\alpha - n)! (i + n - \alpha)!} F^{i+n-\alpha}(\varsigma) f_t^{\alpha-n}(\varsigma, \varphi) \mp \delta_{\alpha} = 0, \quad (11)$$

$$\alpha - i \leq n \leq \alpha$$

где $\alpha = 0, 1, 2, \dots$.

Далее, подставив в (11) разложения (5), (8) и приравняв нулю коэффициенты при одинаковых степенях φ и ς , запишем окончательно искомые соотношения для определения коэффициентов $a_{i, j, k}^{(n)}$:

$$\sum_{M(\alpha, \beta, \gamma)} \frac{a_{i, j, k}^{(n)}}{(\alpha - n)! (i + n - \alpha)! j! k!} F_m^{(i+n-\alpha) \alpha-n} f_{t, \gamma-k-2m, \beta-j+\gamma-k-2m} \mp \delta_{\alpha} \delta_{\beta} \delta_{\gamma} = 0. \quad (12)$$

Здесь $\beta > 0$, $\gamma > 0$ – целые числа; $M(\alpha, \beta, \gamma)$ для каждого набора значений α , β , γ – ограниченная совокупность значений индексов i , j , k , m , n , определяемая неравенствами $0 \leq j \leq \beta$, $0 \leq k \leq \gamma$, $0 \leq m \leq (\gamma - k)/2$, $0 \leq n \leq d$, $\alpha - n \leq i \leq m + \alpha - n$.

Соотношения (9) и (12) позволяют определить все коэффициенты $a_{i, j, k}^{(n)}$. Обозначим $a_{i, k}^{(n)} = a_{i, 0, k}^{(n)}$ | $\delta_{f_1}(\varsigma, \varphi) = \delta_{f_2}(\varsigma, \varphi) = 0$ – значения коэффициентов для недеформированного конденсатора, $a_{i, k}^{(n)} = a_{i, 0, k}^{(n)} - a_{i, k}^{(n)}$ – возмущение коэффициентов.

Ясно, что для невозмущенного конденсатора $\alpha_{i,j,k}^{(n)} = 0$ при $j \geq 1$, поэтому обозначим $\alpha_{i,j,k}^{(n)} = \alpha_{i,j,k}$. Тогда потенциал слабодеформированного тороидального конденсатора запишется в виде

$$U(\eta, \varsigma, \psi) = E \{ U_0(\eta, \varsigma) + U_1(\eta, \varsigma, \psi) \},$$

где $E U_0(\eta, \varsigma)$ – потенциал недеформированного конденсатора:

$$U_0(\eta, \varsigma) = \alpha_{0,0} + \alpha_{1,0} \eta + \frac{1}{2} \alpha_{2,0} \eta^2 + \frac{1}{2} \alpha_{0,2} \varsigma^2 + \frac{1}{2} \alpha_{1,2} \eta \varsigma^2 + \dots$$

Малая добавка $U_1(\eta, \varsigma, \psi)$, характеризующая возмущение потенциала вследствие деформации электродов, имеет вид

$$\begin{aligned} U_1(\eta, \varsigma, \psi) = & \alpha_{0,0} + \alpha_{1,0} \eta + \alpha_{0,1} \varsigma + \alpha_{0,1,0} \psi + \\ & + \frac{1}{2} \alpha_{2,0} \eta^2 + \alpha_{1,1} \eta \varsigma + \alpha_{1,1,0} \eta \psi + \dots \end{aligned} \quad (13)$$

Подставляя в (13) значения коэффициентов, получаемые из (9) и (12), и ограничиваясь в них главным порядком по ϵ и линейным приближением по возмущению δf_1 и δf_2 , имеем

$$U_1(\eta, \varsigma, \psi) = -\frac{\delta}{2} \eta + \frac{1}{2} (1 - F_{\varsigma\varsigma}(0)) \frac{\delta}{2} \eta^2 + \frac{1}{2} F_{\varsigma\varsigma}(0) \frac{\delta}{2} \varsigma^2 - \frac{\delta_3}{2} \eta \varsigma - \frac{\delta_4}{2} \eta \psi. \quad (14)$$

где $\delta = \delta f_1(0,0) - \delta f_2(0,0)$, $\delta_c = \frac{\partial}{\partial c} [\delta f_1(c, \psi) - \delta f_2(c, \psi)] \Big|_{c=\psi=0}$, $\delta_4 = \frac{\partial}{\partial \psi} \times$
 $x [\delta f_1(c, \psi) - \delta f_2(c, \psi)] \Big|_{c=\psi=0}$. Видно, что если $\delta f_1(z, \varphi) = \delta f_2(z, \varphi)$,

то в старшем по ϵ порядке $U_1 = 0$.

Заметим, что формулы для $\alpha_{i,j,k}^{(0)}$, получаемые из (9) и (12), справедливы и в том случае, когда образующая поверхность конденсатора не является окружностью, а задана произвольной симметричной функцией $F(\varsigma)$. Выражения для коэффициентов невозмущенного конденсатора $\alpha_{i,k}^{(0)}$ совпадают с результатами работы [4].

Разложение (14) является искомым выражением для возмущения потенциала электростатического поля, вызванного деформацией электродов тороидального конденсатора. Оно может быть использовано при выводе уравнения движения заряженных частиц в деформированном конденсаторе подобному тому, как это делается в случае отсутствия деформаций.

В заключение рассмотрим вопрос об определении коэффициента тороидальности $c = r_o R_c^{-1}$. Известно [3], что $c = \alpha_{0,2} \alpha_{1,0}^{-1}$. Уравнения (9) и (12) позволяют определить c с любой точностью. В частности, с точностью до квадратичного по ϵ члена

$$\begin{aligned} c = & [-F_{\varsigma\varsigma} - \epsilon \frac{\hat{f}_{1,\varsigma\varsigma} + \hat{f}_{2,\varsigma\varsigma}}{2} + \epsilon^2 \{ (\frac{3}{4} F_{\varsigma\varsigma} + \frac{1}{4}) (\hat{f}_{1,\varsigma\varsigma} - \hat{f}_{2,\varsigma\varsigma}) - \\ & - \frac{1}{2} F_{\varsigma\varsigma\varsigma\varsigma} + F_{\varsigma\varsigma}^3 - F_{\varsigma\varsigma}^2 - \frac{1}{2} F_{\varsigma\varsigma}^3 \}] \Big|_{c=\psi=0} + O(\epsilon^3). \end{aligned}$$

В случае, когда центры аксиальной кривизны пластин конденсатора совпадают,

$$c = c_o - \epsilon^2 \frac{c_o^2 - c_o}{2} + O(\epsilon^3).$$

Если конденсатор сферический ($c_o = 1$), то $c = c_o$. Если $R_o = 2r_o$, т.е. $c_o = 0,5$, то $c \approx \frac{1}{2} (1 + 0,25\epsilon^2)$. При ширине зазора, в десять раз меньше радиуса средней траектории r_o ($\epsilon = 0,05$), коэффициент тороидальности отличается от обычно приближенно используемого значения c_o примерно на 0,06 %. Однако при увеличении ширины зазора или уменьшении радиуса средней траектории значение поправки возрас-

тает и должно приниматься во внимание при расчетах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В.П., Явор С.Я. Электростатические энергоанализаторы для пучков заряженных частиц. М., 1978.- 224 с.
2. Boerboom A.J.H.//Z.Naturforsch. 1960, 15A. N 4. P. 347-350.
3. Wollnik H., Matsuo T., Matsuda H./Nucl. Instr.Meth. 1972.102, N 1. P.13-17
4. Трубачеев Г.М.//Электрофизическая аппаратура. 1977.- № 15.- С.155-158.